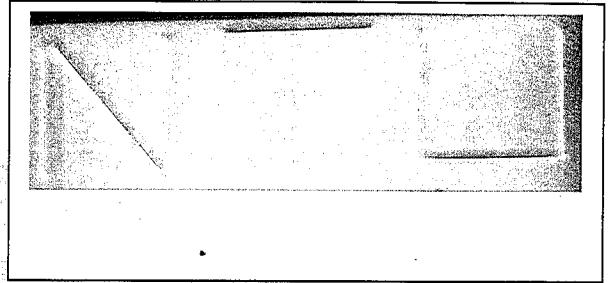




使用介電層自聚焦式之離子束微影技術

發明人：陳敏璋 教授
單位：國立臺灣大學 材料系
簡歷：

[http://www.mse.ntu.edu.tw/index.php?option=com_zoo&task=item
&item_id=47&Itemid=902&lang=tw](http://www.mse.ntu.edu.tw/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=47&Itemid=902&lang=tw)



市場及需求：未來尖端奈米科技需要小於 10 奈米的微縮製程

技術摘要(含成果)：能大範圍的做出小於 10 奈米的圖形

優勢：避開一般傳統光學系統所遇到的困難，以達到小於 10 奈米的微縮能力

競爭產品：EUV He beam lithography

專利現況：美國已有申請專利

Filing to PTO; filing date 9/14/2015 and accorded No 14/852,818

聯絡方式(請不用填)：

臺大產學合作總中心

Tel: 02-3366-9945, E-mail: ntuciac@ntu.edu.tw